

RCNPにおけるビーム強度の増強と 中性子利用

K. Hatanaka, M. Fukuda, T. Yorita, H. Ueda, T. Saito,
H. Tamura, K. Nagayama, M. Kibayashi, Y. Yasuda,
H. Yamamoto, K. Kamakura, N. Hamatani and
S. Morinobu,
Sumitomo Accelerator Service

Research Center for Nuclear Physics, Osaka University

Outline

1. はじめに

- 2. ビーム強度増強に向けた開発
- 3. 新入射器の提案(概念設計)
- 4. 中性子 (ビーム) 利用



RCNP Cyclotrons



Energy of accelerated ions

Ion species accelerated in 2011

Operating statistics



Ring Cyclotron

RCNP Ion Source Complex









Iris 型 diaphragm



1. 高輝度陽子源の開発

● 主な仕様と高輝度化に向けた改良点

・磁場:リング状に配置した3連の永久磁石により生成

・マイクロ波: 2.45 GHz ECR 陽子源 (従来) 200 W → 2 kWに増強 電源と導波管を更新済み

・引き出し電極:4連電極配置による加速・減速電場形成
 プラズマ電極位置の見直し → ECRゾーン側に19mm接近
 電極間の絶縁性向上 → 電極支持板の間隔を拡大

・プラズマチェンバー:内壁に沿ってアルミ製円筒を挿入 マイクロ波導入部側とプラズマ電極側にBN板を設置

→ プラズマチェンバーの導入部を改良予定

プラズマ電極位置の見直し

● 磁場分布とプラズマ電極の位置



マイクロ波パワーの増強(Ⅱ)

● 導波管の更新

・アイソレータ、スタブチューナー、方向性結合器などを更新

・真空窓を水冷化



引き出し電極の改良(Ⅱ)

- 引出電極間の距離を最適化
 - ・IGUNによる引出ビーム軌道計算結果を基に引出電極の配置を見直し ・電極間の距離



引き出し電極の改良(I)

● 引出電極の改造

- ・引出電極(A電極~D電極)の 位置を上流側に19mm移動





ビームエミッタンス@LEBT

【測定条件】

- ·真空度 2.6×10⁻³Pa@引出電極
- ·マイクロ波出力 800W
- ・プラズマ電極 +15kV、電極A +5.7kV、電極B -7kV、電極C & D GND
 ・分析後の陽子ビーム電流値~380µA
- ・ECRスリット
 - 水平&鉛直方向 ±3mm
- ・エミッタンス
 - ε_x~190πmm·mrad (規格化エミッタンス ~1.1πmm·mrad)
 ε_y~ 60πmm·mrad (規格化エミッタンス ~0.34πmm·mrad)





スリット+TPM

高速エミッタンスモニター

スリット+ワイヤ・スキャナー

高速エミッタンスモニター(LEBT)



• 高速スリット

遮蔽板に水平垂直なスリットが切ってある。スリット幅は現在2mm、 パルスモータ駆動;4000pulse/secで全スパン290mmを約70秒で移動。

• BPM83

タングステンの螺旋状ワイヤを備えたビームプロファイルモニタで1/18秒で プロファイルを取得。その間にスリットが動く距離は約0.16mm →スリットの移動による影響は無視できる。

HIPECR / 電極A: 5.7kV / 電極B:-4kV

2012/07/16 04:42.32 (HIPECR)



HIPECR/ 電極A : 5.7kV, 電極B : -9kV

2012/07/16 04:33.28 (HIPECR)



HIPECR / 電極A: 5.7kV / 電極B:-14kV

2012/07/16 04:18.39 (HIPECR)



HIPECR / 電極A: 5.7kV / 電極B: -19kV

2012/07/16 04:07.08 (HIPECR)



ビームエミッタンスの引出電圧依存性(|)

● 電極Aと電極Bの電位に対する依存性 ・VAとVBの電位差が大きい → 高輝度化(低エミッタンス、大電流)



ビームエミッタンスの引出電圧依存性(]])

※IGUNによるシミュレーション計算では、VB = -35kVで最大 輝度が得られる



入射ビーム電流と透過効率



プラズマチェンバー・サイズの最適化(II)

● プラズマチェンバー内に形成されるマイクロ波の電場分布の例



プラズマチェンバーの改良予定

• 改良点

- ・プラズマチェンバーの長さ縮小
- ・マイクロ波導入部のアパーチャー縮小



Emittance monitor in the Beam Analyzing course

Emittance monitor

安

全

Profile Monitor

Emittance monitor Slit Focal plane

Profile Monitor

ビーム電流とエミッタンス@MEBT

● 実ビームでの性能テスト

- ・65MeV@AVF(392MeV@Ring) プロトンビーム
- ·真空度 3.1×10-3Pa@引出電極近傍
- ·マイクロ波出力 300W
- ・電極電位 プラズマ電極 +15kV、電極A +8.0kV
 電極B -12kV、電極C GND、電極D GND
 ・最大電流 ≧0.8mA

・ビーム電流とエミッタンス AVFサイクロトロン垂直軸入射ラインFC 72 μ A ECRスリット 水平及び鉛直方向に±3mm Irisスリット $\phi \sim 10$ mm AVFサイクロトロン加速・引き出し後 $\sim 5\mu$ A(7%) エミッタンス(90%) $\epsilon_x = 6\pi mm \cdot mrad, \epsilon_v = 10\pi mm \cdot mrad$

RCNP K=400 Ring Cyclotron

<u>Magnet</u>

- •Sector magnets
- •Pole gap : 6 cm
- •Maximum magnetic field
- •Trim coils
- •Injection radius
- •Extraction radius
- •Weight

Acceleration system

- •Single gap type
- •Frequency
- •Max. acceleration voltage
- •RF power

- : 6 sets
- : 1.75 T
- : 36 sets
- : 2 m
- : 4 m
- : 2200 tons
- : 3 sets
- : 30 ~ 52 MHz
- : 500 kV
- : 250 kW/cavity

Flat-top cavity

•Single gap type •Frequency

: 1 set : 90 ~ 156 MHz

Key element for high quality beam

World first FT system operating at variable frequencies



RCNP K140 AVF Cyclotron

: 20.6 cm ~ 34.7 cm

: 3.3 m

: 1.6 T

: 16 sets

 $: 3 \sim 5$ sets

: 400 tons

<u>Magnet</u>

Pole diameter
Pole gap
Averaged field
Trim coils
Valley coils
Weight

Acceleration system

•Dee	: Single 180 degrees
•Resonator	: Moving short
•Frequency	: 6 ~ 18 MHz
•Max. acceleration voltage	: 80 kV
•Extraction system : Electro	static deflector
•FT system (k=5,7,9)	

<u>Ion Sources</u> •External ion source

: Atomic beam type polarized ion source, ECR ion source 18 GHz SCECR ion source 2.45GHz ECR proton source







Energy (MeV)

RCNP AVF



大強度、高品質ビームを目指したリングサイクロトロン計画 小型AVF+小リング(SSC1)+大リング(SSC2)

現有AVF + 中型リング(K=400)

AVF → 可変周波数RFQ + SSC

可変周波数 RFQ

概念設計(群馬:山田氏、理研:上垣外氏、...)

- 1. 4 ロッド型
- 2. リングでのハーモニック数 h=6、h=10 に対応して 軽イオン(p、³He)、重イオン用とする



RFQ パラメータ (by PARMTEQ)

軽イオン用:

ベイン長	443 cm
周波数	90 – 155 MHz
質量電荷比	1 – 1.5
入射エネルギー(最高)	50 keV/q
出射エネルギー(最高)	1.64 MeV/q
ベイン間電圧	45 kV
最小ボア半径	0.479 cm
最大変調	2.1
収束係数(B)	3.2
高周波発散	-0.105
最終同期位相	-30°
ベイン長	375 cm
周波数	60 – 105 MHz
質量電荷比	2 - 5
	23
入射エネルギー(最高)	26 keV/q
入射エネルギー(最高) 出射エネルギー(最高)	36 keV/q 0.72 MeV/q
入射エネルギー(最高) 出射エネルギー(最高) ベイン間電圧	2 5 36 keV/q 0.72 MeV/q 42 kV
入射エネルギー(最高) 出射エネルギー(最高) ベイン間電圧 最小ボア半径	36 keV/q 0.72 MeV/q 42 kV 0.308 cm
入射エネルギー(最高) 出射エネルギー(最高) ベイン間電圧 最小ボア半径 最大変調	36 keV/q 0.72 MeV/q 42 kV 0.308 cm 2.3
 入射エネルギー(最高) 出射エネルギー(最高) ベイン間電圧 最小ボア半径 最大変調 収束係数(B) 	36 keV/q 0.72 MeV/q 42 kV 0.308 cm 2.3 7.0
 入射エネルギー(最高) 出射エネルギー(最高) ベイン間電圧 最小ボア半径 最大変調 収束係数(B) 高周波発散 	36 keV/q 0.72 MeV/q 42 kV 0.308 cm 2.3 7.0 -0.14

重イオン用:

PARMTEQ 計算例



NORMALIZED 90% EMITTANCE AND ELLIPSE PARAMETERS (BGS = 0.058444) UNIT IS PI*CM*MRAD FOR X & Y AND PI*MEV*MRAD FOR DP

	EMIT	ERMS	XC	YC	ALPHA	BETA	GAMMA
X – XP	0.124	0.016	0.00	-0.02	-1.4410	665.66	0.003119
Y – YP	0.137	0.018	0.00	0.01	1.9896	871.07	0.004544
DP - DW	6.480	0.665	0.03	-2.56	0.2691	16.63	0.004353

*** OUTPUT SUBROUTINE #7 ************



NORMALIZED 90% EMITTANCE AND ELLIPSE PARAMETERS (BGS = 0.039354) UNIT IS PI*CM*MRAD FOR X & Y AND PI*MEV*MRAD FOR DP

	EMIT	ERMS	XC	YC	ALPHA	BETA	GAMMA
X – XP	0.043	0.008	0.00	-0.01	1.5364	526.21	0.004486
Y – YP	0.042	0.009	0.00	-0.02	-1.0478	276.04	0.003978
DP - DW	8.067	1.554	-0.03	-0.86	0.0239	10.58	0.000054

軽イオン (150MHz)

重イオン (100MHz)

SSC の概念設計(I)

- 1. 周波数範囲はリングサイクロトロンと同じ: 30-52MHz
- 2. 4セクター、平均入射半径:0.5m、平均取出し半径:3m
- 3. ハーモニック数:9(軽イオン)、15(重イオン)
- 4. ディー電極の開き角を17°とする。数値計算の結果、 実質的RF角度は134°、224°となり実効加速電圧は90% 以上である。
- 5. 既設の建物(W実験室)に設置する。実験室の高さに 制限があるため、セクター磁石の磁極幅を33°、ヨーク 幅を50°とする。

	b _{ext}	b _{inj}	V _{inj} (MV)	Br _{inj} (kG·cm)	Br _{ext} (kG·cm)
p 65MeV	0.35409	0.05902	1.64	185	1185
30MeV/u	0.24785	0.04131	1.60	258	1589
22.3MeV/u	0.21476	0.03580	1.44	268	1640

高温超伝導セクター磁石



SSC の概念設計 (II)



SSC n_sect: 4, Sector_angle: 33.0 deg.



SSC n_sect: 4 Sector_angle: 33.0 deg.



平衡軌道



Cu-oxide HTS materials

- 1986: discovery of (La_{1-x}Ba_x)₂CuO₄ J.G. Bednorz and K.A. Müller
- Significant effort went into the development of new and improved conductor materials.
- It became possible to manufacture long HTS wires over km.
 - 1st generation HTS wires ($T_C = 110$ K) Bi₂Sr₂Ca₂Cu₃O₁₀ (Bi-2223)
 - 2^{nd} generation HTS wires (T_C = 95 K) YBa₂Cu₃O₇ (YBCO / Y-123)
- Although many prototype devices using HTS wires have been developed, so far there have been limited applications to accelerators and beam line facilities.

History of transition temperature



First-generation HTS wire

- Wire consists of a a flexible a flexible composite of filaments in a silver alloy matrix with a thin stainless steel lamination that provides mechanical stability and transient thermal conductivity.
- Wire is in thin tape-form approximately 4 mm wide and 0.3mm thick.



 $Bi_2Sr_2Ca_2Cu_3O_x$ (Bi-2223)

(Sumitomo Electric Industries, Ltd.)



Critical current depends on the operating temperature and the strength and direction of magnetic field on the tape surface. It is scaled by Ic at 77K and self field.

Specification of the prototype dipole magnet

- Orbit radius : 400 mm
- Deflection angle: 60 deg.
- Pole gap: 30 mm
- Cold pole
- Laminated pole and yoke for pulsed operation







Double pancake (DP) was wound with applying tensile stress.



Three DP and cooling plates are stacked and fixed with epoxy resin in vacuum.



Each DP was fixed with epoxy resin in vacuum.



9mm and 4.5mm thick iron plates were put on outside and inside of a coil, respectively.

- Coils are fixed to poles to bear the electromagnetic expansion force of 112,000 N/m.
- Poles are formed by stacking 2.3mm thick carbon steel plates.
- Coils and poles weigh 56 and 90kg, respectively. Total weight of the coild mass is 250kg.





Assembled dipole magnet

Cold mass

Excitation by pulsed current



Time (ms)

中性子 (ビーム) の応用@RCNP

- (準単色) 中性子
 - 核反応データベース(高階氏)



- 医療用アイソトープ(高橋氏)
- 半導体の放射線損傷

• 超冷中性子

- 中性子 EDM 測定(増田氏、川崎氏)

進単色中性子







FIG. 8. Zero-momentum-transfer cross sections (c.m.) obtained from Gaussian fits to the experimental cross-section distributions. The solid circles correspond to normalization based upon a constant value for I_q [Eq. (5)]. The open squares correspond to normalization based upon the parametrization of Eq. (1). The dotted line corresponds to a constant c.m. cross section $\sigma_0 = 27.0 \pm 0.8$ mb/sr. The dashed lines represent the one standard deviation limits.

T.N. Taddeucci et al., Phys. Rev. C 41 (1990) 2548-2555

準単色中性子源@RCNP



n-Hall@RCNP



⁷Li target

100 MeV以上の中性子強度と純度



Fig. 11. Neutron energy spectrum for the ${}^{7}Li(p, n){}^{7}Be$ reaction at 295 MeV and 0°. See text for detail.

H. Sakai et al., Nucl. Instr. Meth. A 369 (1996) 120-134 ⁷Li target: 1 cm (0.535 g/cm²) Proton current: 1 μ A Distance from the target: 8 m

 $1.1 \times 10^4 \text{ n/cm}^2/\text{s}$ peak : tails = 1:1 $\Delta E \approx 2-5 \text{ MeV}$

低エネルギー中性子の強度と純度



Intensity of neutrons normalized by the beam current, the target thickness and the solid angle;

(65 MeV) : (30 MeV) : (17 MeV) =1 : 0.21 : 0.11



白色中性子@RCNP

• Study of radiation effects of terrestrial neutrons on LSIs

There are large demands from Industries and Researchers of Information Science and Technology (Osaka Univ., Kyoto Univ., Kyoto Inst. Tech., etc.)

 Production of radioisotopes for nuclear medicine ^{99m}Tc (from ⁹⁹Mo)

Cosmic rays in the terrestrial environment



Radiation effects on integrated circuits



白色中性子源@ RCNP





白色中性子強度@ RCNP



in the world [C. Slayman IRPS 2010]

Neutron energy (MeV)

まとめ

- 1. AVFビーム強度(輝度)増強に向けた開発
- 2. 新入射器の概念設計
- 3. 中性子源@RCNPと利用

